

Физика и техника полупроводников, 2022, том 56, выпуск 6

Неэлектронные свойства полупроводников (атомная структура, диффузия) Anisimov A.N., Breev I.D., Likhachev K.V., Kazarova O.P., Nagalyuk S.S., Baranov P.G., Hubner R., Astakhov G.V., Ber B.Ya., Kazantsev D.Yu., Scheglov M.P., Mokhov E.N. The effect of liquid Silicon on the AlN crystal growth	527
Электронные свойства полупроводников Зикриллаев Х.Ф., Аюпов К.С., Мавлонов Г.Х., Усмонов А.А., Шоабдурахимова М.М. Особенности электрофизических параметров кремния, легированного последовательно примесными атомами фосфора и бора	528
Rozina Ch., Maryam N. Low frequency Compressional modes in degenerate semiconductor plasmas	533
Спектроскопия, взаимодействие с излучениями Когай В.Я., Могилева Т.Н., Фатеев А.Е., Михеев Г.М. Фазовые превращения в композитных пленках системы Se-Cu, полученных взрывной кристаллизацией и термическим отжигом	534
Benemanskaya G.V., Timoshnev S.N., Iluridze G.N., Minashvili T.A. Synchrotron radiation photoemission study of the electronic structure of the ultrathin K/AlN interface	541
Соболев Н.А., Калядин А.Е., Штельмах К.Ф., Шек Е.И., Сахаров В.И., Серенков И.Т. Эффективность возбуждения центров дислокационной люминесценции в кремнии с кислородными преципитатами	542
Sulimov M.A., Sarychev M.N., Mogilnikov I.A., Ivanov V.Yu., Volkov V.A., Zhivulko V.D., Mudryi A.V., Yakushev M.V. Irradiation of Cu(In, Ga)Se₂ Thin Films by 10 MeV Electrons at 77 K: Effect on Photoluminescence Spectra	546
Поверхность, границы раздела, тонкие пленки Середин П.В., Радам Али Обаид, Голощапов Д.Л., Леньшин А.С., Буйлов Н.С., Барков К.А., Нестеров Д.Н., Мизеров А.М., Тимошнев С.Н., Никитина Е.В., Арсентьев И.Н., Шарофидинов Ш., Вавилова Л.С., Кукушкин С.А., Касаткин И.А. Рост тонкопленочных AlGaIn/GaN эпитаксиальных гетероструктур на гибридных подложках, содержащих слои карбида кремния и пористого кремния	547
Полупроводниковые структуры, низкоразмерные системы, квантовые явления Жуков Н.Д., Гавриков М.В., Штыков С.Н. Размерное моделирование синтеза и проводимости коллоидных квантовых точек	553
Аморфные, стеклообразные, органические полупроводники Кастро Арата Р.А., Грабко Г.И., Кононов А.А., Анисимова Н.И., Крбал М., Колобов А.В. Поляризационные процессы в тонких слоях стеклообразной гибридной системы Ge_{28.5}Pb_{14.0}Fe_{1.0}S_{56.5}	559
Микро- и нанокристаллические, пористые, композитные полупроводники Турсынбаев С.А. Влияние освещенности и температуры на тензосвойства кремния с нанокластерами атомов марганца	566
Затонская Л.В., Смагин В.П., Харнутова Е.П., Игнатов Е.В. Фотолюминесценция сульфида цинка, легированного ионами Mn²⁺ и Eu³⁺ в среде додекана	570
Болотов В.В., Князев Е.В., Пономарева И.В., Ивлев К.Е. Многослойная сенсорная структура на основе пористого кремния	576
Холяво И.И., Хомец А.Л., Сафронов И.В., Филонов А.Б., Мигас Д.Б. Влияние морфологии на фононную теплопроводность нанопроволок Si, Ge и Si/Ge типа ядро/оболочка	580

Гапанович М.В., Один И.Н., Левин И.М., Ракитин В.В., Седловец Д.М., Шилов Г.В., Корчагин Д.В. Исследование кристаллической структуры, оптических и электрофизических свойств нового полупроводникового материала Cu_2CrSnS_4 для тонкопленочных солнечных элементов	587
Физика полупроводниковых приборов	
Александров О.В. Размерный эффект в МОП-структурах при ионизирующем облучении	591
Иванов А.М., Клочков А.В. Влияние низкой температуры на электрофизические и шумовые характеристики ультрафиолетовых светодиодов на основе структур с квантовыми ямами InGaN/GaN	596
Бабичев А.В., Михайлов Д.А., Чистяков Д.В., Колодезный Е.С., Гладышев А.Г., Вознюк Г.В., Митрофанов М.И., Денисов Д.В., Слипченко С.О., Лютецкий А.В., Дюделев В.В., Евтихий В.П., Карачинский Л.Я., Новиков И.И., Пихтин Н.А., Егоров А.Ю., Соколовский Г.С. Исследование пространственных характеристик излучения поверхностно-излучающих квантово-каскадных лазеров с кольцевым резонатором	601
Афанасьев А.В., Ильин В.А., Лучинин В.В., Серков А.В., Чигирев Д.А. О формировании низкоомных контактов для биполярных приборов на основе 4H-SiC	607